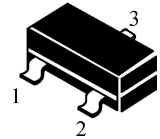


S8550

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■ 最大額定值(Ta=25°C)

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	-40	Vdc
Collect-Emmitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	-25	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	-5.0	Vdc
Collector Current 集電極電流	I_c	-500	mAdc
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	P_C	225	mW
Junction Temperature 結溫	T_j	150	°C
Storage Temperature Range 儲存溫度	T_{stg}	-55~150	°C

■ DEVICE MARKING 打標

S8550=2TY

S8550

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

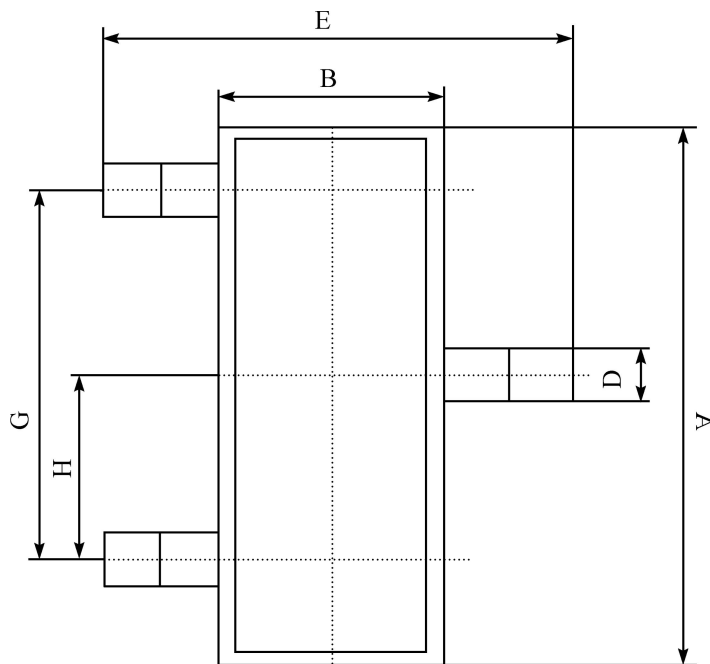
($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明, 溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min. 最小值	Typ. 典型值	Max. 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-30\text{V}, I_E=0$	—	—	-0.1	μA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5\text{V}, I_C=0$	—	—	-0.1	μA
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=-100\mu\text{A}$	-40	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-10\text{mA}$	-25	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-100\mu\text{A}$	-5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	$H_{FE(1)}$	$V_{CE}=-1\text{V}, I_C=-100\text{mA}$	85	—	400	—
	$H_{FE(2)}$	$V_{CE}=-1\text{V}, I_C=-500\text{mA}$	40	—	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}$	—	—	-0.6	V
Base-Emitter Voltage 基極-發射極電壓	V_{BE}	$V_{CE}=-1\text{V}, I_C=-10\text{mA}$	—	-0.8	-1.0	V
Transition Frequency 特徵頻率	f_T	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-10\text{mA}$	100	120	—	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	13	30	pF

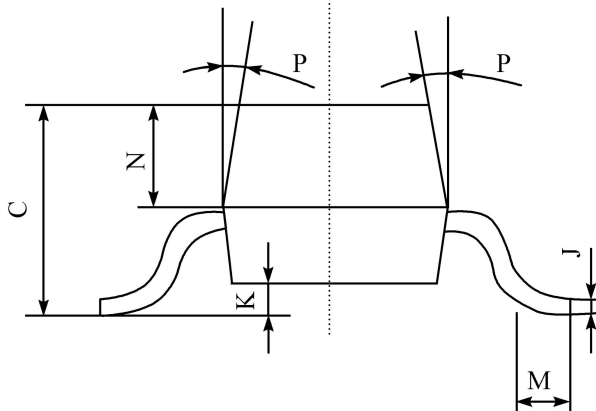
S8550

■ DIMENSION 外形封装尺寸

單位(UNIT): mm



序號	數值及公差
A	2.90 ± 0.10
B	1.30 ± 0.10
C	1.00 ± 0.10
D	0.40 ± 0.10
E	2.40 ± 0.20
G	1.90 ± 0.10
H	0.95 ± 0.05
J	0.13 ± 0.05
K	$0.00 - 0.10$
M	≥ 0.2
N	0.60 ± 0.10
P	$7 \pm 2^\circ$



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>FOSAN\(富信\)](#)